



可对应宽温度晶体振荡器 KC2520M系列 [车载应用]

CMOS/ 1.8V~3.3V/ 2.5×2.0mm



AEC-Q100/200 RoHS指令对应产品

■特点

- 小型低背陶瓷封装
2.5(L)×2.0(W)×0.7(H)mm(Typ.)
- 用缝口密封的高可靠性
- CMOS输出
- 电源电压 可以用于这些规格 1.8/ 2.5/ 3.3V
可对应广泛的电源电压范围 1.6 ~ 3.63V
- 低电流消耗类型

■频率容差 (Overall)

代号	容差 × 10 ⁻⁶	工作温度范围 (°C)	备注
F	±100	-40 ~ +85	工作频率敬请咨询。
G	±50	-40 ~ +105	
6	±50	-40 ~ +105	标准规范
X	±100	-40 ~ +125	

■型号表示方法

KC2520M 25.0000 C 1 □ E SH
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①系列名称
- ②输出频率
- ③输出形式 (CMOS)
- ④电源电压 (可以用于这些规格 1.8V、2.5V、3.3V)
- ⑤频率容差 (参见左表)
- ⑥对称/INH功能 (45/ 55%)
- ⑦个别规格 (产品目录以SH标示)

包装方式 (载带包装 2000个/卷盘)

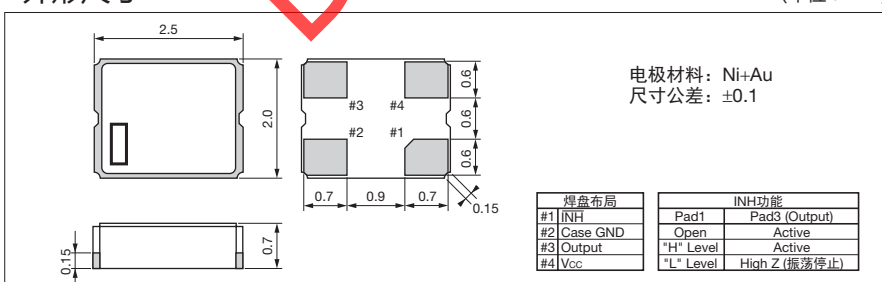
■规格

项 目	记 号	条 件	规 格		单 位
			Min.	Max.	
输出频率范围*	fo		1.5	60	MHz
频率容差	f _{tol}	Temp. : -40 to +85°C	-100	+100	×10 ⁻⁶
		-40 to +125°C			
		Temp. : -40 to +85°C -40 to +105°C	-50	+50	
储存温度范围	T _{stg}		-55	+125	°C
工作温度范围	T _{use}		-40	+125	°C
最大的额定电压	—	1.5 ≤ fo ≤ 60MHz	0.6	+6.5	V
电源电压	V _{cc}		+1.6	+3.63	V
电流消耗 (最大负载时/ 1.6 < V _{cc} ≤ 2.0V)	I _{cc}	1.5 ≤ fo ≤ 24MHz	—	2.5	mA
		24 < fo ≤ 40MHz	—	3.0	
		40 < fo ≤ 60MHz	—	4.5	
电流消耗 (最大负载时/ 2.0 < V _{cc} ≤ 2.8V)	I _{cc}	1.5 ≤ fo ≤ 24MHz	—	3.0	mA
		24 < fo ≤ 40MHz	—	4.0	
		40 < fo ≤ 60MHz	—	5.0	
电流消耗 (最大负载时/ 2.8 < V _{cc} ≤ 3.63V)	I _{cc}	1.5 ≤ fo ≤ 24MHz	—	3.5	mA
		24 < fo ≤ 40MHz	—	5.0	
		40 < fo ≤ 60MHz	—	6.5	
待机时电流	I _{std}		—	10	μA
波形对称	SYM	@50% V _{cc}	45	55	%
上升/下降时间 (10%V _{cc} ~ 90%V _{cc} 最大负载时)	Tr/ Tf	1.6 ≤ V _{cc} ≤ 2.0V	—	6.5	ns
		2.0 < V _{cc} ≤ 2.8V	—	5.5	
		2.8 < V _{cc} ≤ 3.63V	—	4.5	
L电平输出电压	VoL	IoL = 4mA	—	10% V _{cc}	V
H电平输出电压	VoH	IoH = -4mA	90% V _{cc}	—	V
输出负载条件 (CMOS)	L CMOS	CMOS Output	—	15	pF
L电平输入电压	ViL		—	30% V _{cc}	V
H电平输入电压	ViH		70% V _{cc}	—	V
禁用时间	t _{dis}		—	100	ns
启用时间	t _{ena}		—	5	ms
振荡启动时间	t _{str}	最小动作电压为0sec.	—	10	ms
1Sigma Jitter	J _{Sigma}	使用Wavecrest SIA-3000测量	—	8	ps
Peak to Peak Jitter	J _{PK-PK}		—	80	ps

所有的电气特性是以最大负载时, 并在工作温度范围内为条件。 * 输出频率超出该范围的, 敬请咨询。

■外形尺寸

(单位: mm)



■推荐焊盘图案

(单位: mm)

